



Микросхемы К198НТ1А, К198НТ1Б
 К198НТ2А, К198НТ2Б
 К198НТ3А, К198НТ3Б
 К198НТ4А, К198НТ4Б

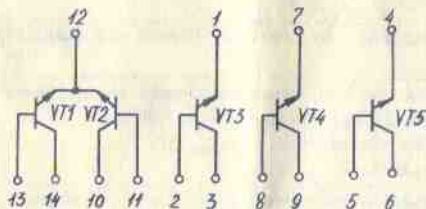
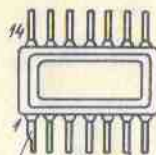


ЭТИКЕТКА

Кремниевые интегральные микросхемы
 "Матрица транзисторов п-р-п типа"

Схема расположения выводов

Схема электрическая принципиальная
 для К198НТ1



для К198НТ2 - без транзистора VT4
 для К198НТ3 - без транзистора VT1
 для К198НТ4 - без транзисторов VT2, VT5

Основные электрические параметры
 (при температуре окружающей среды 25±10°C)

Наименование параметра	Норма	
	К198НТ1А К198НТ2А К198НТ3А К198НТ4А	К198НТ1Б К198НТ2Б К198НТ3Б К198НТ4Б
Статический коэффициент передачи тока транзистора в схеме с общим эмиттером, $h_{21Э}$, (при $U_{КБ}=3В, I_Э=0,5 мА$)	20-125	60-250
Обратный ток коллектора транзистора, $I_{КБО}$, (при $U_{КБ}=6В$), мкА, не более	0,04	
Напряжение насыщения база-эмиттер, $U_{БЭнас}$, (при $I_Э=3мА, I_Б=0,5 мА$), В, не более	1,0	
Напряжение насыщения коллектор-эмиттер, $U_{КЭнас}$, (при $I_К=3мА, I_Б=0,5 мА$), В, не более	0,7	
Разброс статических коэффициентов передачи тока транзисторов дифференциальной пары, $\Delta h_{21Э}$, (при $U_{КБ}=3В, I_Э=0,5мА$), %, не более $\frac{h_{21Эmax} - h_{21Эmin}}{h_{21Эmax} + h_{21Эmin}} \cdot 100$	15	
Разброс напряжения между базой и эмиттером транзисторов дифференциальной пары, $\Delta U_{БЭ}$, (при $I_Э=0,5мА, U_{КБ}=3В$), мВ, не более	4	

Допустимые режимы эксплуатации
 (в диапазоне рабочих температур от минус 45 до +85°C)

Наименование параметра	Норма
Максимально допустимое постоянное напряжение коллектор-база, $U_{КБmax}$, В	20
Максимально допустимое постоянное напряжение коллектор-эмиттер, $U_{КЭRmax}$, (при $R_Б \leq 400 Ом$), В	15
Максимально допустимое постоянное напряжение эмиттер-база, $U_{ЭБmax}$, В	-5
Максимально допустимый постоянный ток коллектора, $I_{Кmax}$, мА	10
Максимально допустимая постоянная рассеиваемая мощность коллектора при температуре до +35°C: - одним транзистором, $P_{Кmax}$, мВт - матрицей, P_{max} , мВт	20 80
Максимально допустимая постоянная рассеиваемая мощность коллектора при температуре до +85°C: - одним транзистором, $P_{Кmax}$, мВт - матрицей, P_{max} , мВт	15 60
Максимально допустимый постоянный ток коллектора транзистора в режиме насыщения, $I_{Кнасmax}$, мА	30

СОДЕРЖАНИЕ ДРАГОЦЕННЫХ МЕТАЛЛОВ

Золото мг в одной микросхеме

19,4737МГ-3л999,9

Технические условия 0.348.004 ТУ

ОТК



Ред.6-78